

BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

[®] Off nl gungsschrift _® DE 197 06 279 A 1

(51) Int. Cl.6: H 01 S 3/025

51022



PATENTAMT

② Aktenzeichen: 197 06 279.2 2 Anmeldetag: 18. 2.97 (3) Offenlegungstag:

20. 8.98

(7) Anmelder:

Siemens AG, 80333 Müńchen, DE

(72) Erfinder:

Erfinder wird später genannt werden

(56) Entgegenhaltungen:

195 11 593 A1 DE 42 38 434 A1 DE

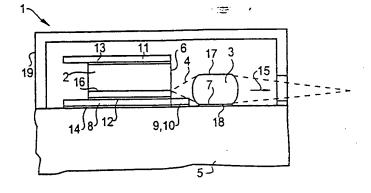
DE-Z.: EPP März 1995, S. 36-37;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(4) Laservorrichtung

Laservorrichtung, bei der ein eine Laserstrahlung aussendender Körper und mindestens ein Element zur Strahlführung oder Strahlabbildung in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind. Das Element zur Strahlführung oder Strahlabbildung ist mittels Silikon in dem Gehäuse befestigt.



Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Laservorrichtung, bei der ein eine Laserstrahlung aussendender Körper und mindestens ein Element zur Strahlführung oder Strahlabbildung der Laserstrahlung in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind. Es bezieht sind insbesondere auf eine Laservorrichtung mit einem Halbleiterlaserchip, insbesondere einem Leistungs-Halbleiterlaser-Barren, und einer Zylinderlinse zur Fokussierung der von dem Halbleiterlaserchip ausgesandten Laserstrahlung, bei der der Halbleiterlaserchip auf einem Grundträgerteil befestigt und die Zylinderlinse vor einer Strahlaustrittsfläche des Halbleiterlaserchips angeordnet ist.

Bislang wird bei derartigen Vorrichtungen das Element 15 zur Strahlführung (z. B. ein Lichtwellenleiter) oder Strahlabbildung (z. B. eine Linse und/oder ein Spiegel) meist sehr aufwendig mittels eines Glaslotes oder eines metallischen Lotes im Gehäuse befestigt.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 20 eine Laservorrichtung der eingangs genannten Art zu entwickeln, die eine einfachere Montage des Elements zur Strahlführung oder Strahlabbildung ermöglicht und bei der ein Verbindungsmittel zwischen dem Element und dessen Montagefläche vorgesehen ist, das hohe Dehnungen ohne 25 plastisches Ermüden übersteht und Laserbestrahlung sehr gut standhält.

Diese Aufgabe wird durch eine Laservorrichtung mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.

Erfindungsgemäß ist das Element zur Strahlführung oder 30 Strahlabbildung mittels Silikon in dem Gehäuse befestigt ist.

Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Laservorrichtung sind Gegenstand der Unteransprüche 2 bis 11.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Laservorrichtung, bei dem der eine Laserstrahlung aussendende Körper ein Halbleiterlaserchip ist, ist das Zwischenträgerteil ein Molybdän-Anschlußrahmen, der mittels phototechnischem Strukturieren einer auf dem Grundträgerteil aufgebrachten Molybdänschicht (z. B. Sputter-, Aufdampfoder Galvanikschicht) hergestellt ist oder als vorgefertigtes Teil (als Leadframe) auf dem Grundträgerteil beispielsweise mittels einer Hartlotschicht befestigt ist. Dies hat den besonderen Vorteil, daß mechanische Spannungen auf Grund von 45 unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen des Halbleiterlaserchips und des Grundträgerteils, das beispielsweise als Wärmesenke dient und z.B. aus Kupfer besteht, größtenteils von dem Zwischenträgerteil kompensiert werden, da Molybdän aufgrund seines hohen Elastizitätsmoduls die me- 50 chanischen Spannungen im elastischen Dehnungsbereich aufnimmt. An Stelle von Molybdän kann selbstverständlicherweise auch ein anderer elektrisch leitender Werkstoff mit einem hohen Elastizitätsmodul, hoher Fließspannung und hoher Temperaturbeständigkeit verwendet sein. Als 55 Beispiele wären hier W, CuW- und CuMo-Legierungen (Cu-Anteil jeweils zwischen 10 und 20%) zu nennen. Alle oben genannten Materialen lassen sich sowohl als Folie als auch als Sputter-, Aufdampf- oder Galvanikschicht herstellen und weisen eine gute Wärmeleitfähigkeit auf.

Die erfindungsgemäße Laservorrichtung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispieles in Verbindung mit der Figur näher erläutert. Die Figur zeigt eine schematische Darstellung eines senkrechten Schnittes durch das Ausführungsbeispiel.

Bei dem Ausführungsbeispiel ist auf einem Grundträgerteil 5 eines Gehäuses 19 ein Zwischenträgerteil 8 befestigt, auf dem sich ein Halbleiterlaserchip 2 befindet. Das Grund-

trägerteil 5 besteht beispielsweise aus Kupfer und das Zwischenträgerteil 8 aus Molybdän. Der Halbleiterlaserchip 2 ist beispielsweise ein Leistungs-Halbleiterlaser-Barren, der im Betrieb eine Mehrzahl von im Querschnitt streifenförmigen, auf einer Geraden nebeneinander angeordneten Einzellaserstrahlen 4 aussendet und aus $Al_xGa_{1-x}As$ ($0 \le x \le 1$) besteht. Dieser Halbleiterlaserchip 2 ist beispielsweise mittels einer Hartlotschicht 12 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) mit dem Zwischenträgerteil 8 verbunden.

Auf der Oberseite des Halbleiterlaserchips 2 ist eine Anschlußplane 11 befestigt, die als zweiter elektrischer Anschluß für den Halbleiterlaserchip 2 vorgesehen ist. Die Anschlußplane 11 besteht bevorzugt aus demselben Material wie das Zwischenträgerteil 8 und ist z. B. ebenfalls mittels einer Hartlotschicht 13 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) auf dem Halbleiterlaserchip 2 befestigt.

Im Falle eines getrennt vom Grundträgerteil 5 hergestellten Zwischenträgerteiles 8 ist dieses ebenfalls bevorzugt mittels einer Hartlotschicht 14 auf dem Grundträgerteil 5 befestigt.

Am Zwischenträgerteil 8 sind zwei Abstandhalterteile 9, 10 ausgebildet, die sich ausgehend von einer Strahlaustrittsfläche 6 des Halbleiterchips 2 in Richtung Strahlausbreitungsrichtung 15 der Laserstrahlung 4 erstrecken und einen Abstand voneinander aufweisen, der größer ist als die Breite der Strahlaustrittsfläche 6, so daß die Laserstrahlung 4 von den Abstandhalterteilen 9, 10 nicht beeinträchtigt wird.

Auf dem Grundträgerteil 5 ist weiterhin eine Zylinderlinse 3 angeordnet, die auf gegenüberliegenden Seiten abgeflachte Seitenflächen 7, 17 aufweist. Die Zylinderlinse 3 liegt mit einer der abgeflachten Seitenflächen 7 auf dem Grundträgerteil 5 auf und mit einer der Strahlaustrittsfläche 6 des Halbleiterlaserchip 2 zugewandten gekrümmten Seitenfläche an den beiden Abstandhalterteilen 9, 10 an und ist mittels einer Silikonschicht 18 auf dem Grundträgerteil 5 befestigt. Silikon-Klebstoffe halten Laserbestrahlung sehr gut stand und überstehen unbeschadet sehr hohe Dehnungen ohne plastisches Ermüden.

Zur Herstellung der oben beschriebenen Zylinderlinsen 3 werden beispielsweise längere Glasfaserstücke von zwei gegenüberliegenden Seiten her beispielsweise mittels Schleifen abgeflacht und anschließend beispielsweise mittels Sägen zu einzelnen Zylinderlinsen zertrennt.

Um die Strahlein- und Strahlauskoppelflächen der Zylinderlinsen 3 optisch zu vergüten, können die Glasfaserstücke zum Beispiel in einer Horde übereinandergestapelt und von beiden Seiten mit einer herkömmlichen optischen Vergütungsschicht versehen werden. Durch die abgeflachten Seitenflächen ist sichergestellt, daß die vergüteten Flächen bei der weiteren Handhabung der Zylinderlinsen 3 nicht verdreht werden.

Die Zylinderlinse 3 ist derart angeschliffen, daß ihr Scheitel genau auf der Höhe des strahlungsemittierenden Bereiches 16 des auf dem Zwischenträgerteil 8 befestigten Halbleiterlaserchips 2 liegt. Der Fokus zwischen dem Halbleiterlaserchip 2 und der Zylinderlinse 3 ist durch die Abstandhalterteile 9, 10 des Zwischenträgerteiles 8 fest vorgegeben.

Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Laservornichtung 1 besteht darin, daß die Zylinderlinse 3 ohne den
Halbleiterlaserchip 2 zu betreiben, gegenüber dem Halbleiterlaserchip 2 justiert und anschließend auf das Grundträgerteil 5 montiert werden kann und nicht mehr in mehreren
Freiheitsgraden ausgerichtet werden muß.

Die Erläuterung der erfindungsgemäßen Laservorrichtung anhand des obigen Ausführungsbeispieles ist selbstverständlicherweise nicht als Einschränkung der Erfindung auf diese spezielle Ausführungsform zu verstehen. Vielmehr bezieht sich die Erfindung auf sämtliche Laservorrichtungen 3

der eingangs genannten Art, s zum Beispiel auch auf Festkörperlaser (wie beispielsweise Rubinlaser), die zusammen mit einem Element zur Strahlführung und/oder Strahlabbildung in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind.

Patentansprüche

1. Laservorrichtung (1), bei der ein eine Laserstrahlung (4) aussendender Körper (2) und mindestens ein Element (3) zur Strahlführung und/oder Strahlabbildung in einem gemeinsamen Gehäuse (18) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Element (3) zur Strahlführung oder Strahlabbildung mittels einer Silikonschicht (18) in dem Gehäuse (19) befestigt ist.

2. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der eine Laserstrahlung (4) aussendende Körper (2) und das Element (3) zur Strahlführung oder Strahlabbildung auf einem gemeinsamen Grundträgerteil (5) befestigt sind, derart daß das Element (3) vor der Strahlaustrittsfläche (6) des Körpers 20 (2) angeordnet ist.

3. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Körper (2) ein Halbleiterlaserchip und das Element (3) eine Zylinderlinse zur Fokussierung der von dem Halbleiterlaserchip ausgesandten 25

Laserstrahlung (4) ist.

4. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Zylinderlinse (3) eine abgeflachte Seitenfläche (7) aufweist, mit der sie auf dem Grundträgerteil (5) aufliegt.

5. Laservorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Zylinderlinse (3) aus einer

Glasfaser gefertigt ist.

6. Laservorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterlaserchip 35

(2) ein Leistungs-Halbleiterlaser-Barren ist.

7. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Halbleiterlaserchip (2) und dem Grundträgerteil (5) ein Zwischenträgerteil (8) vorgesehen ist, das mindestens zwei Abstandhalterteile (9, 10) aufweist, die als Justageanschlag für die Zylinderlinse (3) dienen.

8. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Zylinderlinse (3) an zwei einander gegenüberliegenden Seiten 45

abgeflacht ist.

9. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen den beiden Abstandhalterteilen (9, 10) größer ist als die Breite der Strahlaustrittsfläche (6) des Halbleiterlaserchips (2).

10. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwi-

schenträgerteil (8) Molybdän, CuW oder CuMo auf-

11. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß ein Fokus zwischen dem Halbleiterlaserchip (2) und der Zylinderlinse (3) durch die Länge der Abstandhalterteile (9, 10) des Zwischenträgerteiles 8 fest vorgegeben ist. 60

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

65

